

04;10

Обобщенные уравнения динамики резистивной шланговой неустойчивости РЭП в случае временной зависимости радиуса и тока пучка

© А.С. Мануйлов

Санкт-Петербургский государственный университет,
Научно-исследовательский институт математики и механики им. В.И. Смирнова,
198904 Санкт-Петербург, Россия

(Поступило в Редакцию 10 августа 1998 г.)

Получены обобщенные уравнения, описывающие линейную стадию развития резистивной шланговой неустойчивости РЭП в случае изменения тока и радиуса пучка вдоль импульса. Учтены эффекты, обусловленные наличием обратного тока, возмущения плазменного канала и эволюции проводимости за счет ударной, лавинной ионизации, а также рекомбинации.

1. Новые области применения релятивистских электронных пучков (РЭП) делают актуальным дальнейшее исследование динамики транспортировки РЭП в газоплазменных средах [1–13]. Особый интерес в комплексе проблем, связанных с транспортировкой РЭП, представляет исследование крупномасштабных неустойчивостей пучков, среди которых наибольшую опасность представляет резистивная шланговая неустойчивость (РШН) (азимутальное волновое число $m = 1$), характеризуемая растущими по амплитуде боковыми изгибными колебаниями пучка [1–8].

В настоящей работе разработанная ранее линейная теория РШН РЭП [2,3] обобщена на случай временной зависимости радиуса пучка и тока пучка, произвольных радиальных профилей тока плазмы, пучка и канала проводимости. Кроме того, учтен эффект возмущения проводимости фоновой плазмы при боковых отклонениях РЭП.

2. Рассмотрим параксиальный моноэнергетический аксиально-симметричный РЭП, распространяющийся в газоплазменной среде, характеризуемой скалярной проводимостью $\sigma_{ch0}(\xi)$, вдоль оси z цилиндрической системы координат (r, θ, z) (здесь $\xi = v_z t - z$ — расстояние от фронта пучка до рассматриваемого сечения РЭП, v_z — z -компонента скорости электронов пучка, t — время).

Ограничимся далее случаем высокой проводимости фоновой среды, когда для основной части пучка выполнено условие полной зарядовой нейтрализации пространственного заряда РЭП ($4\pi\sigma_{ch0}R_b/c \gg 1$, где R_b — характерный радиус пучка, c — скорость света). Кроме того, будем считать, что функции $J_{b0}(r)$, $J_{p0}(r)$ и $\sigma_{ch0}(r)$ — произвольные гладкие функции от r , где J_{b0} , J_{p0} — соответственно равновесные плотности тока пучка и фоновой плазмы; σ_{ch0} — омическая проводимость плазмы.

3. Воспользуемся традиционной моделью ”жесткого пучка”, когда предполагается, что боковое смещение РЭП происходит без деформации радиального профиля плотности тока пучка [2,3]. Однако в отличие от работ [2,3] будем предполагать, что проводимость плазмы

σ_{ch} имеет возмущение при боковых отклонениях пучка и нарабатывается за счет процессов ударной ионизации, лавинной ионизации и рекомбинации [10]. Кроме того, будем учитывать временные зависимости полного тока РЭП $I_b(\xi)$ и характерного радиуса пучка $R_b(\xi)$. Переходя от пары независимых переменных (t, z) к паре (ξ, z) , для случая линейной стадии развития РШН параксиальных квазистационарных РЭП получим уравнения динамики неустойчивости в виде

$$\frac{\partial^2 Y}{\partial z^2} = \frac{c\pi}{I_b^2} \left(\frac{I_b}{I_A} \right) \int_0^\infty dr r \left[J_{b1} \frac{\partial A_{z0}}{\partial r} + \frac{J_{b0}}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r A_{z1}) \right], \quad (1)$$

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial A_{z0}}{\partial r} \right) = -\frac{4\pi}{c} (J_{b0} - J_{p0}), \quad (2)$$

$$\frac{\partial}{\partial r} \left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r A_{z1}) \right] - \frac{4\pi}{c} \sigma_{ch0} \frac{\partial A_{z1}}{\partial \xi} - \frac{4\pi}{c} \sigma_{ch1} \frac{\partial A_{z0}}{\partial \xi} = -\frac{4\pi}{c} J_{b1}, \quad (3)$$

где Y — амплитуда поперечного отклонения пучка; J_{b0} и J_{b1} — монополярная и дипольная компонента плотности тока пучка; J_{p0} — плотность равновесного обратного тока; A_{z0} , A_{z1} — равновесная и возмущенная составляющие z -компоненты векторного потенциала электромагнитного поля; σ_{ch1} — возмущенная компонента плазменной проводимости; $I_A = c^3 \beta \gamma m / e$ — предельный ток Альфвена (e , m — заряд и масса электрона; γ — лоренц-фактор; $\beta = v_z / c$).

В рамках модели ”жесткого” пучка можно записать

$$J_{b1} = -Y \frac{\partial J_{b0}}{\partial r}, \quad (4)$$

$$A_{z1} = -D \frac{\partial A_{z0}}{\partial r}, \quad (5)$$

$$\sigma_{ch1} = -Y_{ch} \frac{\partial \sigma_{ch0}}{\partial r}, \quad (6)$$

где D , Y_{ch} — соответственно поперечные смещения оси симметрии коллективного магнитного поля системы плазма–пучок и оси плазменного канала.

С учетом (2), (4) и (5) из (1) нетрудно получить уравнение

$$\frac{\partial^2 Y}{\partial z^2} = k_s^2(\xi)(D - Y), \quad (7)$$

где

$$k_s^2(\xi) = 4\pi^2 \left(\frac{I_b}{I_A} \right) \int_0^\infty dr r \frac{J_{b0}(r, \xi) J_{n0}(r, \xi)}{I_b^2} \quad (8)$$

— квадрат волнового числа шланговых колебаний РЭП, $J_{n0} = J_{b0} - J_{p0}$ — полный равновесный (монополюсный) ток системы плазма–пучок.

Далее рассмотрим полный ток системы плазма–пучок

$$I_n(\xi) = \int_0^\infty dr 2\pi r J_{n0}(r, \xi). \quad (9)$$

Чтобы получить уравнение для I_n , домножим монополюсную компоненту уравнения Ампера (2) на rJ_{n0} и проинтегрируем полученное выражение по r от 0 до ∞ . После ряда преобразований получим

$$\xi_0 \frac{\partial I_n}{\partial \xi} + I_n + I_n^2 F(\xi) = I_b^*, \quad (10)$$

где

$$\xi_0(\xi) = \frac{\int_0^\infty dr r J_{n0}(r, \xi) \sigma_{ch0}(r, \xi) A_{z0}(r, \xi)}{\int_0^\infty dr r [J_{n0}(r, \xi)]^2} \quad (11)$$

— монополюсная скинковая длина,

$$F(\xi) = \frac{\int_0^\infty dr r J_{n0}(r, \xi) \sigma_{ch0}(r, \xi) \frac{\partial}{\partial \xi} \left[\frac{A_{z0}(r, \xi)}{I_n(\xi)} \right]}{\int_0^\infty dr r [J_{n0}(r, \xi)]^2}, \quad (12)$$

$$I_b^*(\xi) = I_n(\xi) \frac{\int_0^\infty dr r J_{b0}(r, \xi) J_{n0}(r, \xi)}{\int_0^\infty dr r [J_{n0}(r, \xi)]^2}, \quad (13)$$

$$A_{z0}(r, \xi) = -\frac{2}{c} \int_{R_c}^r \frac{d\rho}{\rho} I_n(\rho, \xi), \quad (14)$$

где $I_n(\rho, \xi) = \int_0^\rho d\eta 2\pi\eta J_{n0}(\eta, \xi)$ — полный ток системы плазма–пучок в трубке радиуса ρ .

Заметим, что найденное уравнение (10) отличается от полученных ранее в [8,9] третьим слагаемым в левой части уравнения, а также более общим определением ξ_0 и I_b^* . Домножим далее уравнение (3) на $\partial A_{z0}/\partial r$ и проинтегрируем полученное выражение по r от 0 до ∞ .

После ряда громоздких преобразований с учетом (4)–(6) получим

$$\xi_1 \frac{\partial}{\partial \xi} (DI_n) + DI_n + DI_n^2 S(\xi) + Y_{ch} \frac{\partial I_n}{\partial \xi} (\xi_0 - \xi_1) + Y_{ch} I_n^2 [F(\xi) - S(\xi)] = Y I_b^*, \quad (15)$$

где

$$\xi_1 = \frac{c}{4\pi} \frac{\int_0^\infty dr r \sigma_{ch0}(r, \xi) \left(\frac{\partial A_{z0}}{\partial r} \right)}{\int_0^\infty dr r [J_{n0}(r, \xi)]^2} \quad (16)$$

— дипольная скинковая длина, функции $F(\xi)$ определена в (12), ξ_0 дано в (11),

$$S(\xi) = \frac{c}{4\pi} \frac{\int_0^\infty dr r \sigma_{ch0}(r, \xi) \left(\frac{\partial A_{z0}}{\partial r} \right) \frac{\partial}{\partial \xi} \left[\frac{1}{I_n(\xi)} \frac{\partial A_{z0}}{\partial z} \right]}{\int_0^\infty dr r [J_{n0}(r, \xi)]^2}. \quad (17)$$

В отличие от известных результатов работ [8,9] полученное уравнение (15) включает слагаемые с коэффициентами $F(\xi)$ и $S(\xi)$, которые появляются в рассматриваемом случае, когда $\partial I_b/\partial \xi \neq 0$, $\partial R_b/\partial \xi \neq 0$. Кроме того, здесь дано более полное определение параметра I_b^* и все коэффициенты могут быть рассчитаны для произвольных радиальных профилей $J_{b0}(r, \xi)$, $J_{p0}(r, \xi)$ и $\sigma_{ch0}(r, \xi)$.

Уравнение динамики поперечных смещений оси плазменного канала Y_{ch} может быть получено из уравнения генерации проводимости, которое имеет вид

$$\frac{\partial \sigma_{ch}}{\partial \xi} = \Psi J_b(r, \xi) + \frac{\alpha_{av} \sigma_{ch}}{c} - \beta_r \sigma_{ch}^2, \quad (18)$$

где $\Psi \simeq 3 \cdot 10^6$ [cm/A · s] — коэффициент ударной ионизации фонового газа пучком; α_{av} — коэффициент лавинной ионизации, который зависит от $|E|/\rho$, где E — коллективное электрическое поле системы плазма–пучок, ρ — плотность фонового газа [10]; $\beta_r \simeq 7 \cdot 10^{-15} \cdot (\rho/\rho_n)$ [s/cm], где ρ/ρ_n — отношение плотности газа к ее значению при нормальных условиях.

С учетом (4)–(6) дипольная составляющая уравнения наработки проводимости (18) принимает вид

$$\frac{\partial}{\partial \xi} \left(Y_{ch} \frac{\partial \sigma_{ch0}}{\partial r} \right) = \Psi Y \frac{\partial J_{b0}}{\partial r} + Y_{ch} \frac{\alpha_{av}}{c} \frac{\partial \sigma_{ch0}}{\partial r} - 2\beta_r \sigma_{ch0} Y_{ch} \frac{\partial \sigma_{ch0}}{\partial r}. \quad (19)$$

Далее умножим (19) на $r \partial A_{z0}/\partial r$ и проинтегрируем по r от r до ∞ . После ряда преобразований с учетом (2) получим

$$\frac{\partial Y_{ch}}{\partial \xi} + Y_{ch} [G(\xi) + \Gamma(\xi) - \Lambda(\xi)] = Y L(\xi), \quad (20)$$

где

$$G(\xi) = \frac{\int_0^{\infty} dr \frac{\partial \sigma_{ch0}}{\partial r} r J_{n0}(r, \xi)}{T(\xi)}, \quad (21)$$

$$\Gamma(\xi) = \frac{\int_0^{\infty} dr \beta_r(r, \xi) \sigma_{ch0}^2(r, \xi) r J_{n0}(r, \xi)}{T(\xi)}, \quad (22)$$

$$\Lambda(\xi) = \frac{1}{c} \frac{\int_0^{\infty} dr \alpha_{av}(r, \xi) \sigma_{ch0}(r, \xi) r J_{n0}(r, \xi)}{T(\xi)}, \quad (23)$$

$$L(\xi) = \frac{\int_0^{\infty} dr \Psi(r, \xi) J_{b0}(r, \xi) r J_{n0}(r, \xi)}{T(\xi)}, \quad (24)$$

$$T(\xi) = \int_0^{\infty} dr \sigma_{ch0}(r, \xi) r J_{n0}(r, \xi). \quad (25)$$

Полученное уравнение (20)–(25) является обобщением уравнений, приведенных в работе [8], на случай учета лавинной ионизации, рекомбинации, а также временной зависимости всех параметров задачи.

Таким образом, полученные в данной работе уравнения динамики РШН обобщают известные результаты работы [8] на случай временной зависимости тока и радиуса пучка в импульсе. Получены общие формулы для расчета монополюной и дипольной скин-длин, а также определено уравнение, описывающее поперечную динамику плазменного канала с учетом наработки проводимости за счет ударной, лавинной ионизации и рекомбинации.

Список литературы

- [1] Lee E.P., Cooper R.K. // Part. Accel. 1976. Vol. 7. P. 83–95.
- [2] Lee E.P. // Phys. Fluids. 1978. Vol. 21. N 8. P. 1327–1343.
- [3] Uhm H.S., Lampe M. // Phys. Fluids. 1980. Vol. 23. N 8. P. 1574–1585.
- [4] Надеждин Е.Р., Сорокин Г.А. // Физика плазмы. 1983. Т. 9. № 5. С. 988–991.
- [5] Надеждин Е.Р., Сорокин Г.А. // Физика плазмы. 1988. Т. 14. № 5. С. 619–622.
- [6] Колесников Е.К., Мануйлов А.С. // ЖТФ. 1990. Т. 60. Вып. 3. С. 40–44.
- [7] Колесников Е.К., Мануйлов А.С. // ЖТФ. 1991. Т. 61. Вып. 12. С. 43–46.
- [8] Lampe M., Sharp W., Hubbard R.F. et al. // Phys. Fluids. 1984. Vol. 27. N 12. P. 2921–2936.
- [9] Brandenburg J.E. // Sandia Lab. Rep. 1985. N SAND-84-1026. 42 p.
- [10] Ali A.W. // Laser and Particle Beams. 1988. Vol. 6. Pt 1. P. 105–117.
- [11] Колесников Е.К., Мануйлов А.С. // ЖТФ. 1997. Т. 67. Вып. 7. С. 108–111.
- [12] Колесников Е.К., Мануйлов А.С. // РЭ. 1990. Т. 35. № 1. С. 218–220.
- [13] Fernsler R.F., Hubbard R.F., Lampe M. // J. Appl. Phys. 1994. Vol. 75. N 7. P. 3278–3293.